
	<h2 style="color: red;">FQD1N80TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD1N80TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD1N80TM.pdf 2.FQD1N80TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 111229 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N80TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	111229 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD1N80TM ist neu im Original, Suche FQD1N80TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N80TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N80TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD1P50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>	 <p>FQD1P50 FAI FQD1P50 FAI</p>	 <p>FQD1P50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>	 <p>FQD1N80TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>
 <p>FQD1N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N80 FAIRCHILD FQD1N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD1P50TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD17P06TM	↔ FQD18N20V2	⇒ FQD18N20V2TM	D FQD18N20V2TM	⇒ FQD19N10
⊣ FQD19N10L	⊗ FQD19N10LTM	D FQD19N10LTM	⇒ FQD19N10TF	⇒ FQD19N10TF
⊗ FQD19N10TM	⊣ FQD19N10TM	⊗ FQD1N50B	↔ FQD1N50TF	⇒ FQD1N50TF
D FQD1N60C	⊗ FQD1N60CTF	⊣ FQD1N60CTF	⊗ FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60CTM
⇒ FQD1N60TF	↔ FQD1N60TF	⊗ FQD1N60TM	⊣ FQD1N60TM	⇒ FQD1N80TM
↔ FQD1P50TM	⇒ FQD1P50TM	D FQD20N06	⊗ FQD20N06-NL	⊣ FQD20N06L
⊗ FQD20N06LE	D FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LTF	⇒ FQD20N06LTF
⊣ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTM	↔ FQD20N06LTU	⇒ FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TF
⊗ FQD20N06TM	⊣ FQD20N06TM	⊗ FQD24N08	D FQD24N08TF	⇒ FQD24N08TF
↔ FQD24N08TM	⊗ FQD24N08TM	⊣ FQD2N100	⊗ FQD2N100TM	⇒ FQD2N100TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited